南昌大学

物理实验报告



课程名称:	大学物理实验							
实验名称: _	磁滞回线							
学院:	先进制造学院	_ 专业班级:	智造 221 班					
学生姓名:_	朱紫华	_ 学号:	5908122030					
实验 地占:		实验时间 :	2023年月日					

一、 实验目的:

- 1、掌握用磁滞回线测试仪测绘磁滞回线的方法。
- 2、了解铁磁材料的磁化规律,用示波器法观察磁滞回线比较两种典型铁磁物质的动态磁化特性。
 - 3、测定样品的磁化特性曲线(B-H曲线),并作 $\mu-H$ 曲线。
- 4、测绘样品在给定条件下的磁滞回线,估算其磁滞损耗以及相关 H_C 、 B_R 、 B_M 、H、B的等参量。

二、 实验仪器:

TH-MHC 型智能磁滞回线测试仪、示波器。

三、 实验原理:

1. 铁磁材料的磁滞特性

铁磁物质是一种性能特异,用途广泛的材料。铁、钴、镍及其众多合金以及含铁的氧化物(铁氧体)均属铁磁物质。其特性是在外磁场作用下能被强烈磁化,即磁导率 μ 很高。另一特征是磁滞,铁磁材料的磁滞现象是反复磁化过程中磁场强度 H 与磁感应强度 B 之间关系的特性。即磁场作用停止后,铁磁物质仍保留磁化状态,图 1 为铁磁物质的磁感应强度 B 与磁场强度 H 之间的关系曲线。

图中的原点 O 表示磁化之前铁磁物质处于磁中性状态,即 B=H=O,当磁场强度 H 从零开始增加时,磁感应强度 B 随之从零缓慢上升,如曲线 Oa,继之 B 随 H 迅速增长,如曲线 ab 所示,其后 B 的增长又趋缓慢,并当 H 增至 H_S 时, B 达到饱和值 B_S 这个过程的 OabS 曲线称为起始磁化曲线。如果在达到饱和状态之后使磁场强度 H 减小,这时磁感应强度 B 的值也要减小。图 1 表明,当磁场从 H_S 逐渐减小至零,磁感应强度 B 并不沿起始磁化曲线恢复到"O"点,而是沿另一条新的曲线 SR 下降,对应的 B 值比原先的值大,说明铁磁材料的磁化过程是不可逆的过程。比较线段 OS 和 SR 可知,H 减小 B 相应也减小,但 B 的变化滞后于 B 的变化,这种现象称为磁滞。磁滞的明显特征是当 B 中 时,磁感应强度 B 值并不等于 B ,而是保留一定大小的剩磁 B0。

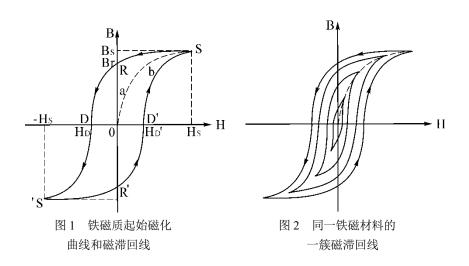
当磁场反向从0逐渐变至 $-H_D$,磁感应强度B消失,说明要消除剩磁,可以施加反向磁场。 H_D 称为矫顽力,它的大小反映铁磁材料保持剩磁状态的能力,曲线RD称为退磁曲线。

图 1 还表明,当磁场按 $H_S \rightarrow O \rightarrow H_C \rightarrow -H_S \rightarrow O \rightarrow H_D' \rightarrow H_S$ 次序变化,相应的磁感应强度 B 则沿闭合曲线SRDS'R'D'S变化,可以看出磁感应强度 B 值的变化总是滞后于磁场强度 H 的变化,这条闭合曲线称为磁滞回线。当铁磁材料

处于交变磁场中时(如变压器中的铁心),将沿磁滞回线反复被磁化→去磁→反向磁化→反向去磁。磁滞是铁磁材料的重要特性之一,研究铁磁材料的磁性就必须知道它的磁滞回线。各种不同铁磁材料有不同的磁滞回线,主要是磁滞回线的宽、窄不同和矫顽力大小不同。

当铁磁材料在交变磁场作用下反复磁化时将会发热,要消耗额外的能量,因为反复磁化时磁体内分子的状态不断改变,所以分子振动加剧,温度升高。使分子振动加剧的能量是产生磁场的交流电源供给的,并以热的形式从铁磁材料中释放,这种在反复磁化过程中能量的损耗称为磁滞损耗,理论和实践证明,磁滞损耗与磁滞回线所围面积成正比。

当初始状态为 H=B=O 的铁磁材料,在交变磁场强度由弱到强依次进行磁化,可以得到面积由小到大向外扩张的一簇磁滞回线,如图 2 所示,这些磁滞回线顶点的连线称为铁磁材料的基本磁化曲线。



可以说磁化曲线和磁滞回线是铁磁材料分类和选用的主要依据,图 3 为常见的两种典型的磁滞回线,其中软磁材料的

磁滞回线狭长、矫顽力小(<102A/m)、 剩磁和磁滞损耗均较小,磁滞特性不显著, 可以近似地用它的起始磁化曲线来表示 其磁化特性,这种材料容易磁化,也容易 退磁,是制造变压器、继电器、电机、交 流磁铁和各种高频电磁元件的主要材料。 而硬磁材料的磁滞回线较宽,矫顽力大 (>102A/m),剩磁强,磁滞回线所包围 的面积肥大,磁滞特性显著,因此硬磁材 料经磁化后仍能保留很强的剩磁,并且这 种剩磁不易消除,可用来制造永磁体。

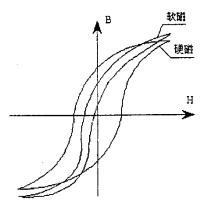


图 3 不同铁磁材料的磁滞回线

2. 测绘磁滞回线原理

观察和测量磁滞回线和基本磁化曲线的线路如图 4 所示。

待测样品为 EI 型矽钢片,N 为励磁绕组,n 为用来测量磁感应强度 B 而设置的绕组。 R_I 为励磁电流取样电阻,设通过 N 的交流励磁电流为 i,根据安培环路定律,样品的磁场强度:

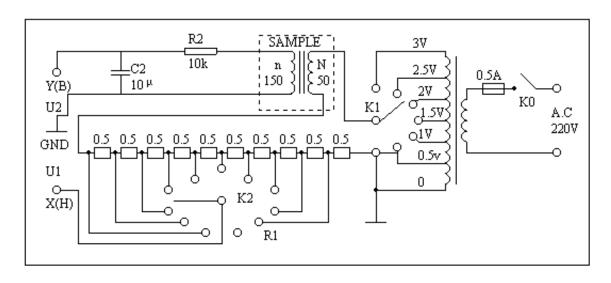


图 4 磁滞回线实验线路

因为
$$i = \frac{U_1}{R_1}$$
 所以 $H = \frac{N \times U_1}{L \times R_1}$ (1)

式(1)中的N、L、 R_1 均为已知常数,磁场强度H与示波器X输入 U_1 成正比,所以由 U_1 可确定H。

在交变磁场下,样品的磁感应强度瞬时值 B 是由测量绕组 n 和 R_2C_2 电路确定的。根据法拉第电磁感应定律,由于样品中的磁通 φ 的变化,在测量线圈中产生的感应电动势的大小为

$$\varepsilon_{2} = n \frac{d\phi}{dt} \qquad (2)$$

$$\phi = \frac{1}{n} \int \varepsilon_{2} dt$$

$$B = \frac{\varphi}{S} = \frac{1}{nS} \int \varepsilon_{2} dt$$

式中 S 为样品的横截面积。考虑到测量绕组 n 较小,如果忽略自感电动势和电路损耗,则回路方程为: $\varepsilon_2 = i_2 r_2 + U_2$

式中 i_2 为感生电流, U_2 为积分电容 C_2 两端电压。设在 Δt 时间内, i_2 向电容 C_2 的充电电量为 O,则

$$U_2 = \frac{Q}{C_2}$$

所以
$$\varepsilon_2 = i_2 R_2 + \frac{Q}{C_2}$$

如果选取足够大的 R_2 和 C_2 ,使得 $i_2R_2>>Q/_{C_2}$,则上式*可以*近似改写为

$$\varepsilon_2 = i_2 R_2$$

因为
$$i_2 = \frac{dQ}{dt} = C_2 \frac{dU_2}{dt}$$

所以
$$\varepsilon_2 = C_2 R_2 \cdot \frac{dU_2}{dt}$$
 (3)

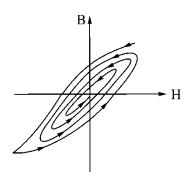
将(3)式两边对时间t积分,代入(2)式可得

$$B = \frac{C_2 R_2}{n_S} \cdot U_2 \quad (4)$$

式中 C_2 、 R_2 、n和s均为已知常数。磁场强度 B 与示波器 Y 输入 U_2 成正比,所以由 U_2 可确定 B。在交流磁化电流变化的一个周期内,示波器的光点将描绘出一条完整的磁滞回线,并在以后每个周期都重复此过程,这样在示波器的荧光屏上可以看到稳定的磁滞回线。综上所述,将图 5 中的 U_1 和 U_2 分别加到示波器的"X 输入"和"Y 输入"便可观察样品的 B-H 曲线;如将 U_1 和 U_2 加到测试仪的信号输入端可测定样品的饱和磁感应强度 B_S 、剩磁 Rr、矫顽力 H_D 、磁滞损耗 BH 以及磁导率 μ 等参数。

四、 实验内容:

(1)电路连接:选样品 1 按实验仪上所给的电路图连接线路,并令 $R_1 = 2.5\Omega$, "U 选择"置于 O 位。 U_H 和 U_B (即 U_1 和 U_2)分别接示波器的"X 输入"和"Y 输入",插孔 \bot 为公共端:



Н

图 5 退磁示意图

图 6 U2 和 B 的相位差等因素引起的畸变

- (2) 样品退磁: 开启实验仪电源,对试样进行退磁,即顺时针方向转动"U选择"旋钮,令U从0增至3V,然后逆时针方向转动旋钮,将U从最大值降为O,其目的是消除剩磁,确保样品处于磁中性状态,即B=H=0,如图5所示;
- (3)观察磁滞回线: 开启示波器电源,调节示波器,令光点位于荧光屏坐标网格中心,令 U=2.2V,并分别调节示波器 x 和 y 轴的灵敏度,使荧光屏上出现图形大小合适的磁滞回线(若图形顶部出现编织状的小环,如图 6 所示,这时可降低励磁电压 U 予以消除)。记录下 $\pm H_s$, $\pm B_s$, $\pm H_c$, $\pm B_r$ 各点坐标值,用 div 表示。(磁滞回线居中);

注意: 磁滞回线应尽量大些,以减小荧光屏读数相对误差。

- (4) 观察基本磁化曲线,按步骤 2 对样品进行退磁,从 U=0 开始,逐档提高励磁电压,将在荧光屏上得到面积由小到大一个套一个的一簇磁滞回线。这些磁滞回线顶点的连线就是样品的基本磁化曲线,记录下各电压下相应 $^{+H_{S}}$, $^{+B_{S}}$ 的坐标值,用 div 表示。注意:实验过程中不能改变示波器 x 和 y 轴的灵敏度。
- (5) 换样品 2, 重复上述步骤, 并观察、比较样品 1 和样品 2 磁化性能的不同。

五、 实验数据及数据分析处理:

(1) µ-H曲线及磁化特性曲线

 $R = \Omega$

U/V	U_H/mV	$H/10^4 A \cdot m^{-1}$	U_B/mV	$B/10^2T$	$\mu(=B/H)/(H/m)$
0.5					
1.0					
1.2					
1.5					
1.8					
2.0					
2.2					
2.5					
2.8					
3.0					

(2) 磁滞回线

序号	U_H/mV	U_B/mV	序号	U_H/mV	U_B/mV
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

- 六、 误差分析
- 七、 实验小结与思考
- 八. 附上原始数据: